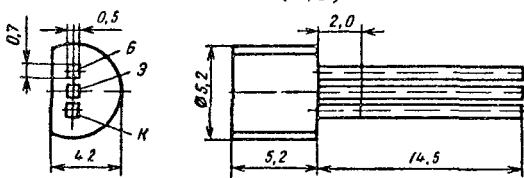


КТ660 (А, Б)

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* переключаемые. Предназначены для применения в переключающих и импульсных устройствах, в цепях вычислительных машин в генераторах электрических колебаний. Корпус пластмассовый с гибкими выводами. Тип прибора указывается в этикетке. На транзистор наносится условная цветная маркировка КТ660А — одна синяя полоса, КТ660Б — две синие полосы.

Масса транзистора не более 0,3 г

КТ660 (А, Б)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 10$ В, $I_B = 2$ мА

Температура T	КТ660А	КТ660Б
$T = +25^\circ\text{C}$	110	220
$T = +85^\circ\text{C}$	90	264
$T = -45^\circ\text{C}$	30	220

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K = 500$ мА, $I_B = 50$ мА, не более	КТ660А
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА, не более	0,05 В

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_K = 500$ мА, $I_B = 50$ мА, не более	КТ660Б
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В, не более	10 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = U_{КБ, макс}$, не более:	
$T = -45...+25^\circ\text{C}$	1 мкА
$T = +85^\circ\text{C}$	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭВ} = 4$ В, не более	0,5 мкА

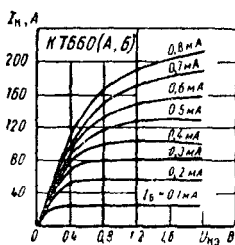
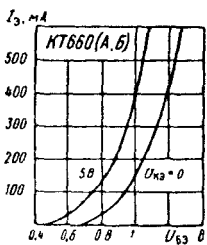
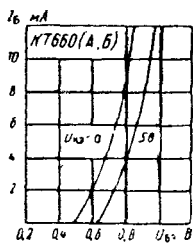
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база:	
КТ660А	50 В
КТ660Б	30 В
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{63} \leq 1$ кОм:	
КТ660А	45 В
КТ660Б	30 В
Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $I_B = 10$ мА, $R_{63} = \infty$:	
КТ660А	30 В
КТ660Б	25 В
Постоянное напряжение база — эмиттер	5 В
Постоянный ток коллектора	800 мА
Импульсный ток коллектора при $t_u \leq 10$ мкс, $Q \geq 5$	1000 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
при $T = -45...+25^\circ\text{C}$	0,5 Вт
при $T = +85^\circ\text{C}$	0,25 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $t_u \leq 10$ мкс, $Q \geq 5$, $T = -45...+55^\circ\text{C}$	1 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+150 $^\circ\text{C}$
Температура окружающей среды	-45...+85 $^\circ\text{C}$

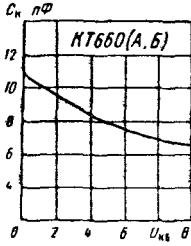
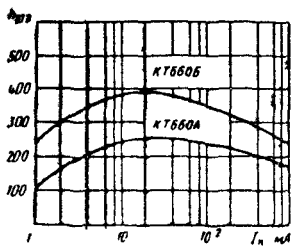
1 При $T = +25...+85^\circ\text{C}$ $R_{K, макс}$ уменьшается линейно.

Пайка выводов транзисторов рекомендуется не ближе 2 мм от корпуса при температуре припоя +260 $^\circ\text{C}$ в течение не более 10 с, время лужения 2 с. Допускается только одна перепайка выводов.

Допустимое значение статического потенциала 1000 В.

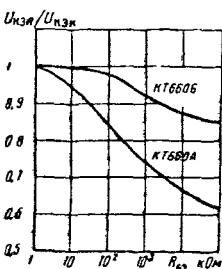
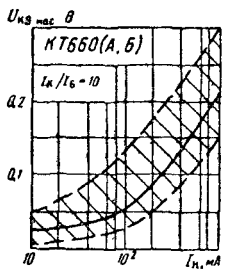
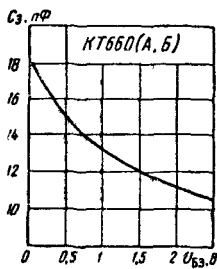


Входные характеристики Зависимости тока эмиттера от напряжения база — эмиттер Выходные характеристики



Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора

Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор — база



Зависимость емкости эмиттерного перехода от напряжения база — эмиттер

Зона возможных положений зависимости на графиках зависимости напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока коллектора

Зависимости постоянно напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер